

850nm 10Gbps GaAs PD Chip $\phi 60\mu\text{m}$



产品描述

850nm GaAs PIN 高速光探测器芯片

产品特点

数据速率高达 10-40Gbps; $\phi 60\mu\text{m}$ 有效面积; 850nm 高响应度; 正面阳极/阴极焊盘

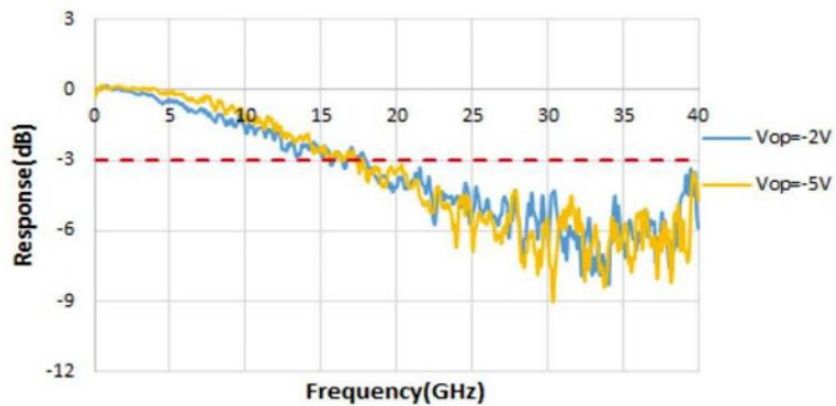
应用领域

10G/40G SR4 AOC | 4×10Gbps 光纤通道 | 40Gbps QSFP | HDMI 2.1

核心参数

无
无

详细参数



规格 (Tc=25°C, 单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ		850	860	nm	
响应度	R	0.55	0.6		A/W	$\lambda=850\text{nm}$
暗电流	I_D		0.08	0.3	nA	$V_R=-5V$
电容	C		0.14	0.16	pF	$V_R=-2V, f=1\text{MHz}$
带宽	Bw		12		GHz	$V_R=-2V$ 3dB down, $R_L=50\Omega$
有效区直径	D		60		μm	
通道之间的中心间距 (pitch)			250		μm	